

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載

【部門区分】第 6 部門第 2 区分

【発行日】平成 21 年 8 月 20 日 (2009.8.20)

【公開番号】特開 2007-47775 (P2007-47775A)

【公開日】平成 19 年 2 月 22 日 (2007.2.22)

【年通号数】公開・登録公報 2007-007

【出願番号】特願 2006-194663 (P2006-194663)

【国際特許分類】

G 0 9 G 3/30 (2006.01)

G 0 9 G 3/20 (2006.01)

G 0 9 G 3/36 (2006.01)

H 0 1 L 51/50 (2006.01)

G 0 2 F 1/133 (2006.01)

【F I】

G 0 9 G 3/30 J

G 0 9 G 3/20 6 1 1 A

G 0 9 G 3/20 6 2 4 B

G 0 9 G 3/20 6 4 1 D

G 0 9 G 3/36

G 0 9 G 3/20 6 2 1 M

G 0 9 G 3/20 6 8 0 G

H 0 5 B 33/14 A

G 0 2 F 1/133 5 5 0

G 0 9 G 3/20 6 2 2 G

【手続補正書】

【提出日】平成 21 年 7 月 8 日 (2009.7.8)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】発明の名称

【補正方法】変更

【補正の内容】

【発明の名称】半導体装置

【手続補正 2】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項 1】

ビデオ信号が入力されるユニットと、

第 1 の配線と、

第 2 の配線と、

前記第 1 の配線に直列に挿入された第 1 のスイッチと、

前記ユニットと前記第 1 の配線とを電氣的に接続する第 2 のスイッチとを有し、

前記第 2 の配線で前記ユニットが選択されていない場合には前記第 1 のスイッチがオンとなり、

前記第 2 の配線で前記ユニットが選択され、前記ビデオ信号が前記ユニットに入力される場合には前記第 1 のスイッチがオフとなることを特徴とする半導体装置。

## 【請求項 2】

ビデオ信号が入力されるユニットと、  
第 1 の配線と、  
第 2 の配線と、  
前記第 1 の配線に直列に挿入された第 1 のトランジスタと、  
前記ユニットと前記第 1 の配線とを電氣的に接続する第 2 のトランジスタとを有し、  
前記第 2 の配線で前記ユニットが選択されていない場合には前記第 1 のトランジスタがオンとなり、  
前記第 2 の配線で前記ユニットが選択され、前記ビデオ信号が前記ユニットに入力される場合には前記第 1 のトランジスタがオフとなることを特徴とする半導体装置。

## 【請求項 3】

ビデオ信号が入力されるユニットと、  
第 1 の配線と、  
第 2 の配線と、  
前記第 1 の配線に直列に挿入された第 1 のトランジスタと、  
前記ユニットと前記第 1 の配線とを電氣的に接続する第 2 のトランジスタとを有し、  
前記第 1 のトランジスタのゲートは前記第 2 の配線に電氣的に接続され、  
前記第 1 のトランジスタのソース及びドレインの一方は前記第 2 のトランジスタのソース及びドレインの一方に電氣的に接続され、  
前記第 2 のトランジスタのゲートは前記第 2 の配線に電氣的に接続され、  
前記第 2 のトランジスタのソース及びドレインの他方は前記ユニットに電氣的に接続されていることを特徴とする半導体装置。

## 【請求項 4】

ビデオ信号が入力されるユニットと、  
第 1 の配線と、  
第 2 の配線と、  
第 3 の配線と、  
前記第 1 の配線に直列に挿入された第 1 のトランジスタと、  
前記ユニットと前記第 1 の配線とを電氣的に接続する第 2 のトランジスタとを有し、  
前記第 2 の配線で前記ユニットが選択されていない場合には前記第 1 のトランジスタがオンとなり、  
前記第 2 の配線で前記ユニットが選択され、前記ビデオ信号が前記ユニットに入力される場合には前記第 1 のトランジスタがオフとなり、  
前記第 2 のトランジスタのゲートは前記第 3 の配線に電氣的に接続されていることを特徴とする半導体装置。

## 【請求項 5】

ビデオ信号が入力されるユニットと、  
第 1 の配線と、  
第 2 の配線と、  
第 3 の配線と、  
前記第 1 の配線に直列に挿入された第 1 のトランジスタと、  
前記ユニットと前記第 1 の配線とを電氣的に接続する第 2 のトランジスタとを有し、  
前記第 1 のトランジスタのゲートは前記第 3 の配線に電氣的に接続され、  
前記第 1 のトランジスタのソース及びドレインの一方は前記第 2 のトランジスタのソース及びドレインの一方に電氣的に接続され、  
前記第 2 のトランジスタのゲートは前記第 2 の配線に電氣的に接続され、  
前記第 2 のトランジスタのソース及びドレインの他方は前記ユニットに電氣的に接続され、  
前記第 1 のトランジスタのゲートに入力される信号は、前記第 2 のトランジスタのゲートに入力される信号の反転信号であることを特徴とする半導体装置。

## 【請求項 6】

請求項 1 において、  
前記スイッチはアナログスイッチであることを特徴とする半導体装置。

## 【請求項 7】

請求項 1 乃至 3 のいずれか一において、  
前記第 1 の配線はソース信号線であり、  
前記第 2 の配線はゲート信号線であることを特徴とする半導体装置。

## 【請求項 8】

請求項 4 または 5 において、  
前記第 1 の配線はソース信号線であり、  
前記第 2 の配線は第 1 のゲート信号線であり、  
前記第 3 の配線は第 2 のゲート信号線であることを特徴とする半導体装置。

## 【請求項 9】

請求項 2 または 3 において、  
前記第 1 のトランジスタと前記第 2 のトランジスタは逆極性であることを特徴とする半導体装置。

## 【請求項 10】

請求項 4 または 5 において、  
前記第 1 のトランジスタと前記第 2 のトランジスタは同極性であることを特徴とする半導体装置。

## 【請求項 11】

請求項 1 乃至 10 のいずれか一において、  
前記ユニットは、表示素子と、前記表示素子を制御する回路とを含むことを特徴とする半導体装置。

## 【請求項 12】

請求項 1 乃至 11 のいずれか一において、  
前記ユニットは表示素子として発光素子を有していることを特徴とする半導体装置。

## 【請求項 13】

請求項 1 乃至 11 のいずれか一において、  
前記ユニットは表示素子として EL 素子を有していることを特徴とする半導体装置。

## 【請求項 14】

請求項 1 乃至 11 のいずれか一において、  
前記ユニットは表示素子として液晶素子を有していることを特徴とする半導体装置。